



第三届全国新型半导体功率器件及应用技术研讨会 (会议日程安排)

指导单位：中国半导体行业协会

**主办单位：中国半导体行业协会半导体分立器件分会
株洲中车时代电气股份有限公司**

**承办单位：新型功率半导体器件国家重点实验室
专用集成电路重点实验室**

河北普兴电子科技股份有限公司

中国电子科技集团公司第十三研究所

协办单位：合肥锐拓科技信息服务有限公司

长沙欧信会议服务有限公司

《半导体技术》编辑部

《微纳电子技术》编辑部

2017年11月24—27日 长沙

ULVAC

CEIC

中国电子科技集团公司第四十八研究所
THE 48TH RESEARCH INSTITUTE OF CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP CORPORATION

HWT

NOKIDA

上海轩田工业设备有限公司

一. 会议总体议程

日期	时间	地点	安排
11月24日	全天	长沙雅士亚华美达广场酒店 (雨花区万家丽中路三段199号)	全天代表报到
11月25日	上午	8:30—12:05	6楼牡丹厅会议室
	工作午餐		
	下午	13:30—18:00	6楼牡丹厅会议室
特邀报告、大会报告			
11月26日	上午	8:30—12:00	6楼牡丹厅会议室
	工作午餐		
	下午	13:30—18:00	6楼牡丹厅会议室
大会报告			

二. 11月25日上午：开幕式、特邀报告

时间：8:30—12:00 地点：6楼牡丹厅会议室

主持人：赵小宁 中国半导体行业协会半导体分立器件分会秘书长

1. 开幕式

8:30—8:40	致开幕辞	中国半导体行业协会半导体分立器件分会理事长	杨克武 先生
8:40—8:50	嘉宾致辞	中国半导体行业协会副理事长	陈 贤 先生
8:50—9:00	嘉宾致辞	中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼总工程师	冯江华 先生

2. 特邀报告

时间	题 目	报 告 人
09:00—09:30	后 IGBT 时代的技术研发与产业化战略思考	株洲中车时代电气股份有限公司副总工程师 刘国友 教授
09:30—10:00	集成功率器件与隔离技术的进展	电子科技大学微电子与固体电子学院 李泽宏 教授
10:00—10:30	汽车 IGBT 芯片研发及其封装解决方案	新型功率半导体器件国家重点实验室主任助理 罗海辉 博士
10:30—11:00	氮化镓毫米波器件进展	专用集成电路重点实验室 冯志红 研究员
11:00—11:30	碳化硅电力电子器件技术及应用	深圳基本半导体有限公司总经理 和巍巍 博士
11:30—11:50	新型功率半导体制造中的离子注入工艺及设备	爱发科株式会社营业部 山崎嘉文 课长
11:50—12:05	大功率 IGBT 铝碳化硅散热基板超高热等静压制备工艺的研究	江苏凯讯新材料有限公司 傅蔡安 教授

三. 11月25日下午：特邀报告、大会报告

时间：13:30—18:00 地点：6楼牡丹厅会议室

主持人：赵小宁 中国半导体行业协会半导体分立器件分会秘书长

13:30-14:00	SiC MOSFET-技术、器件和应用	英飞凌科技中国有限公司工业功率控制事业部 高级经理 陈子颖 先生
14:00-14:30	氮化镓功率电子器件及其应用	苏州捷芯威半导体有限公司总裁 裴 轶 博士

14:30-15:00	SiC 高温高能离子注入机的开发、验证及应用	中国电子科技集团公司第四十八研究所 易文杰 研究员
15:00-15:15	IGBT 模块封装用 AlSiC 基板关键技术研究	湖南浩威特科技发展有限公司总工 杨盛良 先生
15:15-15:30	半导体功率器件生产智能制造总体规划	上海轩田工业设备有限公司副总经理 裘峥宏 先生

主持人：冯志红 专用集成电路重点实验室副主任

序号	题 目	单 位	报告人
1	功率器件在新能源汽车中的应用分析	上汽大众汽车有限公司	朱明磊
2	超高压 4H-SiC 双极性功率器件材料相关问题	东莞市天域半导体科技有限公司	孙国胜
3	高压 SiC ETO 器件及其脉冲功率应用研究	湖南大学电气与信息工程学院	曾程
4	CVD 单晶金刚石合成及其应用	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	江南
5	Optically-pumped Lasing with Q-factor Exceeding 6000 from Wet-etched GaN Micro-pyramids	中南大学	汪炼成
6	GaN and SiC epitaxial production technologies for high volume manufacturing of efficient power semiconductor devices	AIXTRON China Limited	方子文
7	1700V SiC 功率模块应用于地铁辅助变流器特性研究	北京交通大学电气学院	黄先进
8	SiC MOS 器件瞬态温升及热阻的测量研究	北京工业大学	石帮兵
9	半导体功率器件封装用新型陶瓷基板技术	华中科技大学机械科学与工程学院	陈明祥
10	利用亚微米级别分辨率的反射率热成像技术对功率半导体器件进行热测试	上海坤道信息技术有限公司	王力

四. 11月26日上午：大会报告

时间：8:30—12:00 地点：6楼牡丹厅会议室

主持人：王俊 湖南大学电气与信息工程学院教授

序号	题 目	单 位	报告人
1	GaN Systems 氮化镓器件特性及其应用	GaN Systems Inc.	李全春
2	衬底减薄对 AlGaN/GaN HEMT 电学性能的影响	北京工业大学	朱慧
3	β -Ga ₂ O ₃ 单晶 Si 掺杂样品分析	中国电子科技集团公司第四十六研究所	程红娟
4	射频横向扩散场效应晶体管的MIM电容可靠性优化工艺	上海华虹宏力半导体制造有限公司	蔡莹
5	高导热环氧塑封料的研究	江苏华海诚科新材料股份有限公司	成兴明
6	热管理用超高导热金刚石/Al 复合材料	哈尔滨工业大学材料科学与工程学院	张强
7	IGBT 模块高温反偏试验实时测温技术研究	北京工业大学	郭春生
8	IGBT 半导体功率器件预成型无铅焊片研究	上海华庆焊材技术有限公司	吴坚
9	4H-SiC 基快中子探测器的器件结构设计	西安电子科技大学 微电子学院	王莎

10	微波等离子体化学气相沉积单晶金刚石与宽禁带半导体功率器件	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	徐帅
11	ITO-220AB 封装功率 VDMOS 器件的热阻特性分析	电子科技大学微固学院	高巍
12	更具有折中优势的 IGBT 器件超级结-绝缘栅双极性晶体管 (SJ-IGBT)	上海华虹宏力半导体制造有限公司	潘嘉
13	星载电源模块 VDMOS 器件并联瞬态电流均衡特性研究	中国空间技术研究院	张宝林
14	非焊膏贴装工艺与高性能互连技术在 IGBT 封装中的应用	深圳市顺昱自动化设备有限公司	庞晓东

五. 11月26日下午：大会报告

时间：13:30—18:00 地点：6楼牡丹厅会议室

主持人：计建新 无锡华润微电子研发中心助理总经理

序号	题 目	单 位	报告人
1	超级结器件的发展	上海华虹宏力半导体制造有限公司	王飞
2	A 3-D Analytical Model of Surface Electric Field for SOI Lateral Super Junction Devices with Non-Equilibrium Concentration	南京邮电大学	李曼
3	面向产业化应用的 8 英寸硅基 GaN 外延材料	上海微技术工业研究院	袁理
4	硅基氮化镓功率器件专用设备的开发	中晟光电设备（上海）股份有限公司	张森
5	高温炉管内残留的 Trans_LC 对功率器件的影响及一种解决办法	上海华虹宏力半导体制造有限公司	李秀然
6	金刚石微波功率器件模型研究	电子科技大学电子工程学院	付裕
7	SiC 肖特基二极管封装热阻检测技术的研究	北京工业大学	何鑫
8	1200V Trench-FS IGBT 设计	西安龙腾新能源科技发展有限公司	闫宏丽
9	三电平逆变器故障诊断方法研究	长春理工大学	陈晓娟
10	功率器件封装超声键合强度均匀性技术控制研究	株洲中车时代电气股份有限公司	周铮
11	GaN 基 HEMT 器件的陷阱分析及表征技术	北京工业大学	郑翔
12	适用大功率 IGBT 的门极驱动过流检测保护方法的研究	北京交通大学电气学院	田超
13	基于 Marx 和 LTD 拓扑的全固态复合模式高压纳秒脉冲源研制	重庆大学电气工程学院	谭坚文
14	基于碱土金属的 SiC MOS 界面模型的仿真分析	西安电子科技大学 微电子学院	揭佳敏
15	SiC 外延生长工艺中三角形缺陷的控制	中国电子科技集团公司第四十八研究所	丁杰钦
16	高能重离子引起的部分耗尽 SOI 器件潜在可靠性降低的研究	中国科学院新疆理化技术研究所	周书星
17	功率 VDMOS 器件结温在线测量的研究	北京工业大学	姜舶洋
18	功率循环下厚膜组装 VDMOS 的焊接层的分析	中国电子科技集团公司第四十三研究所	汪张超